



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2015년04월08일

(11) 등록번호 10-1509119

(24) 등록일자 2015년03월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

H05B 33/26 (2006.01) H01L 29/786 (2006.01)

H01L 51/50 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2008-0069621

(22) 출원일자 2008년07월17일

심사청구일자 2013년06월20일

(65) 공개번호 10-2010-0008969

(43) 공개일자 2010년01월27일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020020028636 A*

KR1020060079225 A*

KR1020070082977 A

KR1020070055087 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

삼성디스플레이 주식회사

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

(72) 발명자

김수현

충남 천안시 서북구 두정중2길 12, 106동 1101호
(두정동, 두정e-편한세상아파트)

박선

경기 화성시 영통로61번길 10, 102동 804호 (반월동, 신영통현대1차아파트)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

팬코리아특허법인

전체 청구항 수 : 총 16 항

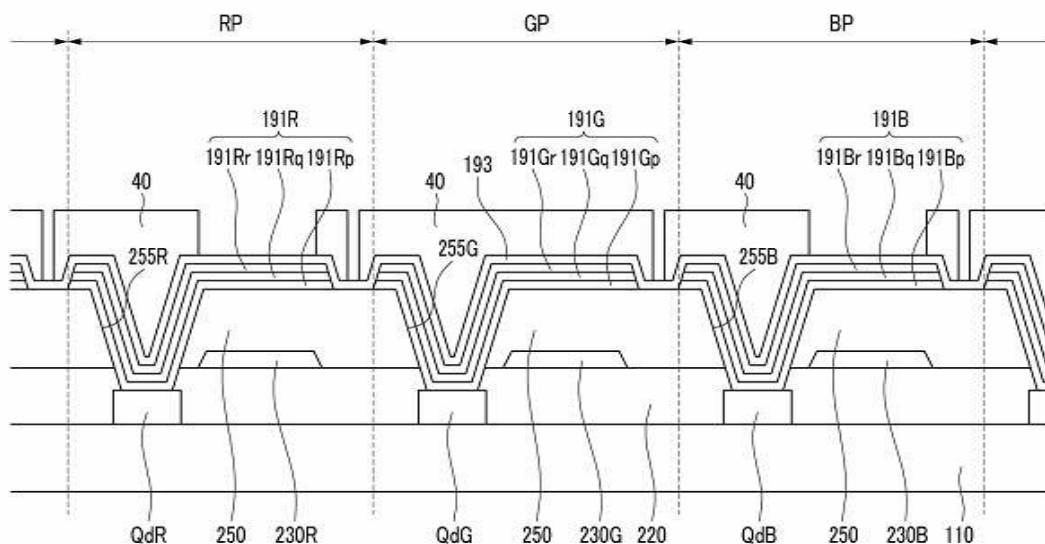
심사관 : 조훤

(54) 발명의 명칭 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 한 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은, 제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 포함하는 기판 위에 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 구동 트랜지스터를 형성하는 단계, 상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터 위에 절연막을 형성하는 단계, 상기 절연막 위의 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 화소 전극을 형성하는 단계, 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면에 도전성 보호 부재를 형성하는 단계, 상기 제1 내지 제3 화소 전극 위에 유기 발광 부재를 형성하는 단계, 그리고 상기 유기 발광 부재 위에 공통 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

대표도 - 도4



(72) 발명자

유춘기

경기 화성시 병점동로 23, 105동 1205호 (병점동,
구봉마을우남퍼스트빌1차아파트)

박종현

충청북도 청주시 상당구 사북로149번길 7, 세원임
대아파트 101동 806호 (우암동)

이동기

경기도 성남시 분당구 미금로 66, - 402동 301호
(구미동, 무지개마을)

이윤규

경기도 용인시 기흥구 농서로 84, 상록수동 705호
(농서동)

명세서

청구범위

청구항 1

제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 포함하는 기관,

상기 기관 위에 형성되어 있으며 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 위치하는 제1, 제2 및 제3 구동 트랜지스터,

상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터 위에 형성되어 있는 절연막,

상기 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 위치하는 제1, 제2 및 제3 화소 전극,

상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면을 각각 덮는 제1, 제2 및 제3 도전성 보호 부재,

상기 제1 내지 제3 화소 전극 중 적어도 하나의 상부에 형성되어 있고, 상기 도전성 보호 부재와 일체로 이루어진 광로 길이 조절 전극,

상기 제1 내지 제3 화소 전극 위에 형성되어 있는 유기 발광 부재, 그리고

상기 유기 발광 부재 위에 형성되어 있는 공통 전극

을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에서,

상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 각각은 금속막과 상기 금속막 위에 형성되어 있는 투명 도전체막을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 4

제3항에서,

상기 금속막은 은 또는 알루미늄을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 5

삭제

청구항 6

제3항에서,

상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 각각은 상기 금속막 아래에 형성되어 있는 금속 산화물막을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 7

제6항에서,

상기 광로 길이 조절 전극은 비정질 ITO(indium tin oxide) 또는 비정질IZO(indium zinc oxide)를 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 8

제7항에서,

상기 투명 도전체막 및 상기 금속 산화물막은 다결정 ITO 또는 다결정 IZO를 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 9

제8항에서,

상기 투명 도전체막, 상기 금속막 및 상기 금속 산화물막은 실질적으로 동일한 평면 모양을 가지는 유기 발광 표시 장치.

청구항 10

제9항에서,

상기 제1, 제2 및 제3 도전성 보호 부재를 덮으며 상기 광로 길이 조절 전극을 노출하는 복수의 개구부를 가지는 격벽을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 11

제9항에서,

상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터와 상기 금속 산화물막 사이에 위치하는 색필터를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 12

기관 위에 형성되어 있는 박막 구조물,

상기 박막 구조물 위에 형성되어 있으며, 금속막과 상기 금속막 위의 투명 도전체막을 포함하는 화소 전극,

상기 금속막의 측면을 덮는 도전성 보호 부재,

상기 도전성 보호 부재와 일체로 이루어진 광로 길이 조절 전극,

상기 화소 전극 위에 형성되어 있으며 상기 화소 전극과 접촉하는 유기 발광 부재, 그리고

상기 유기 발광 부재 위에 형성되어 있는 공통 전극

을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 13

제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 포함하는 기관 위에 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 구동 트랜지스터를 형성하는 단계,

상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터 위에 절연막을 형성하는 단계,

상기 절연막 위의 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 화소 전극을 형성하는 단계,

상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면에 도전성 보호 부재를 형성하는 단계,

상기 제1 내지 제3 화소 전극 중 적어도 하나의 상부에, 상기 도전성 보호 부재와 동시에 광로 길이 조절 전극을 형성하는 단계,

상기 제1 내지 제3 화소 전극 위에 유기 발광 부재를 형성하는 단계, 그리고

상기 유기 발광 부재 위에 공통 전극을 형성하는 단계

를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 14

제13항에서,

상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면에 도전성 보호 부재를 형성하는 단계는,

상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 위에 투명한 제1 도전체막을 적층하는 단계, 그리고

상기 제1 도전체막을 사진 식각하는 단계
를 포함하는
유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 15

삭제

청구항 16

삭제

청구항 17

제13항에서,
상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 형성 단계는,
제1, 제2 및 제3 도전체막을 차례로 적층하는 단계, 그리고
상기 제1 내지 제3 도전체막을 사진 식각하여 하부막, 중간막 및 상부막을 형성하는 단계를 포함하는
유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 18

제17항에서,
상기 중간막은 알루미늄 또는 은을 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 19

제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 포함하는 기판 위에 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 구동 트랜지스터를 형성하는 단계,
상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터 위에 절연막을 형성하는 단계,
상기 절연막 위의 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 화소 전극을 형성하는 단계,
상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면에 도전성 보호 부재를 형성하는 단계,
상기 제1 내지 제3 화소 전극 위에 유기 발광 부재를 형성하는 단계,
상기 유기 발광 부재 위에 공통 전극을 형성하는 단계를 포함하고,
상기 도전성 보호 부재는 ITO 또는 IZO를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 20

제19항에서,
상기 제1 및 제3 도전체막은 비정질 ITO 또는 비정질 IZO를 포함하며,
상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 형성 단계는 상기 비정질 ITO 또는 상기 비정질 IZO를 결정화하는 단계를 더
포함하는
유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

발명의 설명

발명의 상세한 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 유기 발광 표시 장치는 복수의 화소를 포함하며, 각 화소는 유기 발광 소자(organic light emitting element)와 이를 구동하기 위한 복수의 박막 트랜지스터를 포함한다.

[0003] 유기 발광 소자는 애노드와 캐소드 및 그 사이의 유기 발광 부재 등을 포함하는데, 유기 발광 부재는 적색, 녹색, 청색 등 삼원색의 빛을 내거나 흰색의 빛을 낸다. 유기 발광 부재가 내는 색상에 따라서 재료가 달라지며, 백색광을 내는 경우에는 적색, 녹색, 청색의 빛을 내는 발광 재료들을 적층하여 합성광이 백색이 되도록 하는 방법을 주로 사용하고 있다. 또한, 유기 발광 부재가 백색광을 내는 경우에는 색필터를 추가하여 원하는 색상의 빛을 얻기도 한다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

[0004] 그런데 유기 발광 소자의 재료 특성 또는 빛이 통과하는 박막 등에 의한 광간섭으로 인하여 각 화소에서 나오는 빛이 파장이나 색순도 등의 광특성 조건을 충족하지 못할 수 있다.

[0005] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 유기 발광 표시 장치의 광특성을 개선하는 것이다.

과제 해결수단

[0006] 본 발명의 한 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는, 제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 포함하는 기관, 상기 기관 위에 형성되어 있으며 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 위치하는 제1, 제2 및 제3 구동 트랜지스터, 상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터 위에 형성되어 있는 절연막, 상기 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 위치하는 제1, 제2 및 제3 화소 전극, 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면을 각각 덮는 제1, 제2 및 제3 도전성 보호 부재, 상기 제1 내지 제3 화소 전극 위에 형성되어 있는 유기 발광 부재, 그리고 상기 유기 발광 부재 위에 형성되어 있는 공통 전극을 포함한다.

[0007] 상기 유기 발광 표시 장치는 상기 제1 내지 제3 화소 전극 중 적어도 하나의 상부에 형성되어 있는 광로 길이 조절 전극을 더 포함할 수 있다.

[0008] 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 각각은 금속막과 상기 금속막 위에 형성되어 있는 투명 도전체막을 포함할 수 있다.

[0009] 상기 금속막은 은 또는 알루미늄을 포함할 수 있다.

[0010] 상기 도전성 보호 부재와 상기 광로 길이 조절 전극은 일체로 이루어질 수 있다.

[0011] 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 각각은 상기 금속막 아래에 형성되어 있는 금속 산화물막을 더 포함할 수 있다.

[0012] 상기 광로 길이 조절 전극은 비정질 ITO(indium tin oxide) 또는 비정질 IZO(indium zinc oxide)를 포함할 수 있다.

[0013] 상기 투명 도전체막 및 상기 금속 산화물막은 다결정 ITO 또는 다결정 IZO를 포함할 수 있다.

[0014] 상기 투명 도전체막, 상기 금속 및 상기 금속 산화물막은 실질적으로 동일한 평면 모양을 가질 수 있다.

[0015] 상기 유기 발광 표시 장치는 상기 제1, 제2 및 제3 도전성 보호 부재를 덮으며 상기 광로 길이 조절 전극을 노출하는 복수의 개구부를 가지는 격벽을 더 포함할 수 있다.

[0016] 상기 유기 발광 표시 장치는 상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터와 상기 금속 산화물막 사이에 위치하는 색필터를 더 포함할 수 있다.

[0017] 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는, 기관 위에 형성되어 있는 박막 구조물, 상기 박막 구조물 위에 형성되어 있으며, 금속막과 상기 금속막 위의 투명 도전체막을 포함하는 화소 전극, 상기 금속막의 측면을 덮는 도전성 보호 부재, 상기 화소 전극 위에 형성되어 있으며 상기 화소 전극과 접촉하는 유기 발광

부재, 그리고 상기 유기 발광 부재 위에 형성되어 있는 공통 전극을 포함한다.

- [0018] 본 발명의 한 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은, 제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 포함하는 기판 위에 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 구동 트랜지스터를 형성하는 단계, 상기 제1 내지 제3 구동 트랜지스터 위에 절연막을 형성하는 단계, 상기 절연막 위의 상기 제1, 제2 및 제3 영역에 각각 제1, 제2 및 제3 화소 전극을 형성하는 단계, 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면에 도전성 보호 부재를 형성하는 단계, 상기 제1 내지 제3 화소 전극 위에 유기 발광 부재를 형성하는 단계, 그리고 상기 유기 발광 부재 위에 공통 전극을 형성하는 단계를 포함한다.
- [0019] 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 측면에 도전성 보호 부재를 형성하는 단계는, 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 위에 투명한 제1 도전체막을 적층하는 단계, 그리고 상기 제1 도전체막을 사진 식각하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0020] 상기 방법은 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극의 적어도 하나의 상부에 광로 길이 조절 전극을 형성하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 도전성 보호 부재와 상기 광로 길이 조절 전극은 동시에 형성될 수 있다.
- [0021] 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 형성 단계는, 제1, 제2 및 제3 도전체막을 차례로 적층하는 단계, 그리고 상기 제1 내지 제3 도전체막을 사진 식각하여 상기 하부막, 상기 중간막 및 상기 상부막을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0022] 상기 중간막은 알루미늄 또는 은을 포함할 수 있고, 상기 도전성 보호 부재는 ITO 또는 IZO를 포함할 수 있으며, 상기 제1 및 제3 도전체막은 비정질 ITO 또는 비정질 IZO를 포함하며, 상기 제1, 제2 및 제3 화소 전극 형성 단계는 상기 비정질 ITO 또는 상기 비정질 IZO를 결정화하는 단계를 더 포함할 수 있다.

효 과

- [0023] 이와 같이 함으로써 유기 발광 표시 장치의 광특성을 개선하는 한편, 금속막의 손상을 방지할 수 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0024] 그러면, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
- [0025] 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.
- [0026] 먼저 도 1을 참고하여 본 발명의 한 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치에 대하여 상세하게 설명한다.
- [0027] 도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 등가 회로도이다.
- [0028] 도 1을 참고하면, 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 복수의 신호선(121, 171, 172)과 이들에 연결되어 있으며 대략 행렬(matrix)의 형태로 배열된 복수의 화소(pixel)(PX)를 포함한다.
- [0029] 신호선은 게이트 신호(또는 주사 신호)를 전달하는 복수의 게이트선(gate line)(121), 데이터 신호를 전달하는 복수의 데이터선(data line)(171), 구동 전압을 전달하는 복수의 구동 전압선(driving voltage line)(172) 등을 포함한다. 게이트선(121)은 대략 행 방향으로 뻗어 있으며 서로가 거의 평행하고 데이터선(171)은 대략 열 방향으로 뻗어 있으며 서로가 거의 평행하다. 구동 전압선(172)은 대략 열 방향으로 뻗어 있는 것으로 도시되어 있으나, 행 방향 또는 열 방향으로 뻗거나 그물 모양으로 형성될 수 있다.
- [0030] 각 화소(PX)는 스위칭 트랜지스터(swimming transistor)(Qs), 구동 트랜지스터(driving transistor)(Qd), 유지 축전기(storage capacitor)(Cst) 및 유기 발광 소자(organic light emitting element)(LD)를 포함한다.
- [0031] 스위칭 트랜지스터(Qs)는 제어 단자(control terminal), 입력 단자(input terminal) 및 출력 단자(output terminal)를 가지는데, 제어 단자는 게이트선(121)에 연결되어 있고, 입력 단자는 데이터선(171)에 연결되어 있으며, 출력 단자는 구동 트랜지스터(Qd)에 연결되어 있다. 스위칭 트랜지스터(Qs)는 게이트선(121)으로부터 받은 주사 신호에 응답하여 데이터선(171)으로부터 받은 데이터 신호를 구동 트랜지스터(Qd)에 전달한다.
- [0032] 구동 트랜지스터(Qd) 또한 제어 단자, 입력 단자 및 출력 단자를 가지는데, 제어 단자는 스위칭 트랜지스터(Q

s)에 연결되어 있고, 입력 단자는 구동 전압선(172)에 연결되어 있으며, 출력 단자는 유기 발광 소자(LD)에 연결되어 있다. 구동 트랜지스터(Qd)는 제어 단자와 출력 단자 사이에 걸리는 전압에 따라 그 크기가 달라지는 출력 전류(ILD)를 흘린다.

- [0033] 축전기(Cst)는 구동 트랜지스터(Qd)의 제어 단자와 입력 단자 사이에 연결되어 있다. 이 축전기(Cst)는 구동 트랜지스터(Qd)의 제어 단자에 인가되는 데이터 신호를 충전하고 스위칭 트랜지스터(Qs)가 턴 오프(turn-off)된 뒤에도 이를 유지한다.
- [0034] 유기 발광 소자(LD)는 예를 들면 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED)로서, 구동 트랜지스터(Qd)의 출력 단자에 연결되어 있는 애노드(anode)와 공통 전압(Vss)에 연결되어 있는 캐소드(cathode)를 가진다. 유기 발광 소자(LD)는 구동 트랜지스터(Qd)의 출력 전류(ILD)에 따라 세기를 달리하여 발광함으로써 영상을 표시한다.
- [0035] 스위칭 트랜지스터(Qs) 및 구동 트랜지스터(Qd)는 n-채널 전계 효과 트랜지스터(field effect transistor, FET)이지만, 이들 적어도 하나는 p-채널 전계 효과 트랜지스터일 수 있다. 또한, 트랜지스터(Qs, Qd), 축전기(Cst) 및 유기 발광 소자(LD)의 연결 관계가 바뀔 수 있다.
- [0036] 경우에 따라서는 스위칭 트랜지스터(Qs)와 구동트랜지스터(Qd) 외에도 구동 트랜지스터(Qd)나 유기발광 소자(LD)의 문턱 전압 보상을 위한 다른 트랜지스터들이 더 있을 수 있다.
- [0037] 그러면 도 1에도시한 유기 발광 표시 장치의 상세 구조에 대하여 도 2를 도 1과 함께 참고하여 상세하게 설명한다.
- [0038] 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 단면도이다.
- [0039] 본 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는, 적색 화소(RP), 녹색 화소(GP) 및 청색 화소(BP)를 포함한다. 적색, 녹색, 청색의 삼원색 대신 다른 색상의 삼원색 화소를 포함할 수도 있다.
- [0040] 도면에서 적색 화소(RP), 녹색 화소(GP), 청색 화소(BP)와 관련된 부분들에 대해서는 각각 도면 부호의 숫자 뒤에 R, G, B를 붙였다.
- [0041] 투명한 유리 또는 플라스틱 따위로 만들어진 절연 기판(110) 위에 복수의 구동 트랜지스터(QdR, QdG, QdB)가 형성되어 있다. 기판(110) 위에는 이외에도 스위칭 트랜지스터를 포함하는 다른 박막 구조물(220)이 형성되어 있다. 이러한 박막 구조물 중에는 구동 트랜지스터를 덮는 절연막도 있을 수 있으며, 구동 트랜지스터(QdR, QdG, QdB)의 아래에도 다른 박막 구조물이 형성될 수 있다.
- [0042] 박막 구조물(220) 위에는 적색 색필터(230R), 녹색 색필터(230G), 청색 색필터(230B)가 형성되어 있고, 색필터(230R, 230G, 230B) 및 박막 구조물(220) 위에는 덮개막(250)이 형성되어 있다. 덮개막(250)은 유기물로 만들어질 수 있으며, 표면이 평탄할 수 있다. 덮개막(250) 및 박막 구조물(220)에는 구동 트랜지스터(QdR, QdG, QdB) 위에 위치한 복수의 관통 구멍(255R, 255G, 255B)이 형성되어 있다.
- [0043] 덮개막(250) 위에는 복수의 화소 전극(191R, 191G, 191B)이 형성되어 있다. 각각의 화소 전극(191R, 191G, 191B)은 하부막(191Rp, 191Gp, 191Bp), 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq) 및 상부막(191Rr, 191Gr, 191Br)을 포함하는 3중막 구조를 가진다. 화소 전극(191R, 191G, 191B)은 접촉 구멍(255R, 255G, 255B)을 통하여 구동 트랜지스터(QdR, QdG, QdB)와 연결되어 있다.
- [0044] 하부막(191Rp, 191Gp, 191Bp)은 다결정 ITO(indium tin oxide)나 IZO(indium zinc oxide) 등의 금속 산화물로 만들어질 수 있으며, 두께는 약 50~150 , 특히 약 75 일 수 있다. 하부막(191Rp, 191Gp, 191Bp)은 유기물인 덮개막(250)에서 유출될 수 있는 산소나 수분으로부터 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)을 보호하며 생략될 수 있다.
- [0045] 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)은 은(Ag), 마그네슘-은(Mg:Ag) 합금, 알루미늄(Al) 따위의 반사도가 높은 금속으로 만들어질 수 있으며 두께는 약 125~250 , 특히 약 200 일 수 있다. 이와 같이 금속이라도 두께가 얇으면 입사광이 반사되기도 하고 투과되기도 하는 반투과 특성을 가지게 된다.
- [0046] 상부막(191Rr, 191Gr, 191Br)은 다결정 ITO나 IZO 등의 투명한 도전체로 만들어질 수 있으며, 두께는 약 50~150 , 특히 약 75 일 수 있다.
- [0047] 하부막(191Rp, 191Gp, 191Bp), 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq) 및 상부막(191Rr, 191Gr, 191Br)은 실질적으로 동

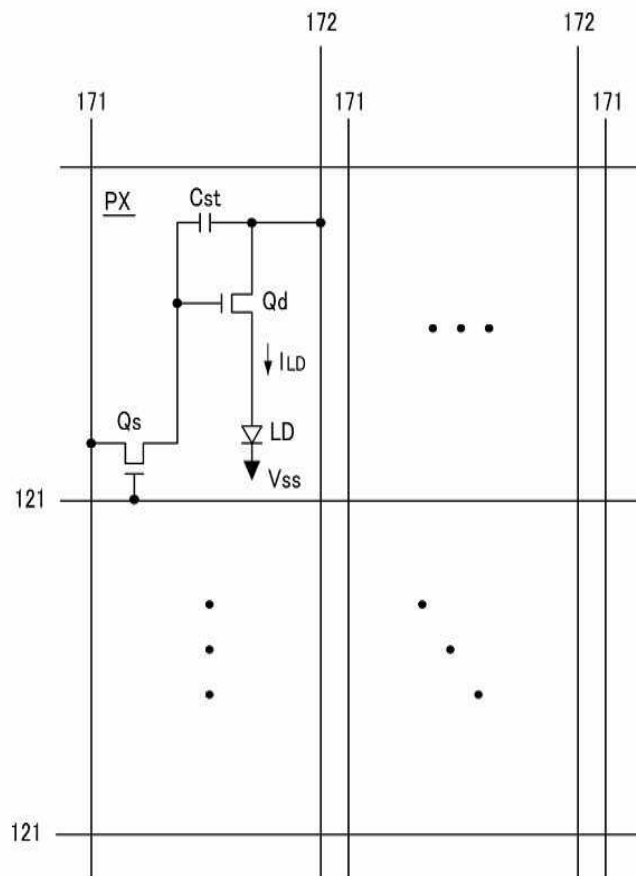
일한 평면 모양을 가지며, 이에 따라 그 측면이 모두 노출되어 있다.

- [0048] 화소 전극(191R, 191G, 191B) 및 덮개막(250) 위에는 보조 전극(193R, 193G, 193B)이 형성되어 있다. 보조 전극(193R, 193G, 193B)은 비정질 ITO나 IZO 등의 금속 산화물로 만들어질 수 있으며, 두께는 약 700~800 , 특히 약 750 일 수 있다.
- [0049] 보조 전극(193R, 193G, 193B)은 화소 전극(191R, 191G, 191B)의 측면, 특히 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)의 측면을 덮어 보호한다. 적색 화소(RP) 및 청색 화소(BP)의 보조전극(193R, 193B)은 화소 전극(191R, 191B)의 측면 외에 상면의 가장자리를 덮으나 중앙 부분은 덮지 않는다. 그러나 녹색 화소(GP)의 보조전극(193G)은 화소 전극(191G)의 측면과 상면을 모두 덮는다.
- [0050] 이 때, 각 화소(RP, GP, BP)의 측면을 덮는 도전성 보호 부재(도시하지 않음)와 녹색 화소(GP)의 상면 위에 위치하는 광로 길이 조절 전극은 따로 형성되어 있을 수 있다.
- [0051] 보조 전극(193R, 193G, 193B), 화소 전극(191R, 191B) 및 덮개막(250) 위에는 격벽(361)이 형성되어 있다. 격벽(361)은 적색 화소(RP) 및 청색 화소(BP)의 화소 전극(191R, 191B)을 노출하는 개구부(365R, 365B)와 녹색 화소(GP)의 보조전극(193G)을 노출하는 개구부(365G)를 가진다. 적색 화소(RP) 및 청색 화소(BP)의 보조 전극(193R, 193B)은 격벽(361)으로 가려져 노출되지 않는다.
- [0052] 화소 전극(191R, 191B), 보조 전극(193G) 및 격벽(361) 위에는 백색 유기 발광 부재(370)가 형성되어 있으며, 그 위에는 공통 전압(Vss)을 전달하는 공통 전극(270)이 형성되어 있다.
- [0053] 백색 유기 발광 부재(370)는 기본색 중 서로 다른 색의 빛을 내는 복수의 유기 물질층이 적층된 구조를 가질 수 있으며, 공통 전극(270)은 칼슘(Ca), 바륨(Ba), 마그네슘(Mg), 알루미늄, 은 등을 포함하는 반사성 금속으로 만들어질 수 있다.
- [0054] 이러한 유기 발광 표시 장치에서, 화소 전극(191R, 191G, 191B), 백색 유기 발광 부재(370) 및 공통 전극(270)은 유기 발광 소자(LD)를 이루며, 화소 전극(191R, 191G, 191B)이 애노드, 공통 전극(270)이 캐소드가 된다.
- [0055] 이러한 유기 발광 표시 장치는 기관(110)의 아래쪽으로 빛을 내보내어 영상을 표시한다. 백색 유기 발광 부재(370)에서 기관(110) 쪽으로 방출된 빛은 보조 전극(193G)[단, 녹색 화소(GP)만 해당] 및 화소 전극(191R, 191G, 191B)의 상부막(191Rr, 191Gr, 191Br)을 통과하여 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)에 이른다. 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)은 입사광을 공통 전극(270) 쪽으로 반사하며 공통 전극(270)은 이를 다시 반사하여 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)로 보낸다. 이와 같이 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)과 공통 전극(270) 사이에서 왕복하는 빛은 간섭 등의 광학적 과정을 거치고 적절한 조건이 되면 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq) 및 색필터(230R, 230G, 230B)를 통과하여 바깥으로 나간다.
- [0056] 이때, 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq)과 공통 전극(270)의 사이에 있는 박막들의 두께와 굴절률 등에 따라 빛의 경로가 달라지므로 이들 박막의 두께와 재질 등을 적절하게 선택하면 원하는 광학적 특성, 예를 들면 원하는 범위의 파장과 색순도를 가지는 빛을 얻을 수 있다.
- [0057] 상부막(191Rr, 191Gr, 191Br)의 두께를 정할 때, 세 화소(RP, GP, BP) 모두가 원하는 광학적 특성을 얻을 수 있는 두께는 나오기 어렵기 때문에, 적색 화소(RP)와 청색 화소(BP)가 공통적으로 원하는 광학적 특성을 얻을 수 있는 두께로 설정한다. 그런 후 녹색 화소(GP)에 대해서는 원하는 광학적 특성이 나올 수 있는 두께를 가진 보조 전극(193G)을 상부막(191Gr) 위에 남겨 둔다. 이런 방식으로 세 화소(RP, GP, BP) 모두에 대하여 원하는 광학적 특성을 얻을 수 있다.
- [0058] 그러면, 도 3 내지 도 6을 참고하여 도 2에 도시한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 대하여 상세하게 설명한다.
- [0059] 도 3 내지 도 6은 도 2에 도시한 유기 발광 표시 장치를 제조하는 중간 단계에 있는 구조물의 단면도이다.
- [0060] 도 3을 참고하면, 기관(110) 위에 복수의 구동 트랜지스터(QdR, QdG, QdB), 박막 구조물(220) 및 복수의 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성한 다음, 감광성 유기물 따위로 만들어진 덮개막(250)을 도포하고 노광, 현상하여 덮개막(250) 및 박막 구조물(220)에 복수의 관통 구멍(255R, 255G, 255B)을 형성한다.
- [0061] 이어 비정질 ITO막, 은막, 비정질 ITO막의 3중막을 적층하고 사진 식각하여 화소 전극(191R, 191G, 191B)의 하부막(191Rp, 191Gp, 191Bp), 중간막(191Rq, 191Gq, 191Bq) 및 상부막(191Rr, 191Gr, 191Br)을 형성한 다음, 열처리하여 비정질 ITO를 다결정 ITO로 결정화한다.

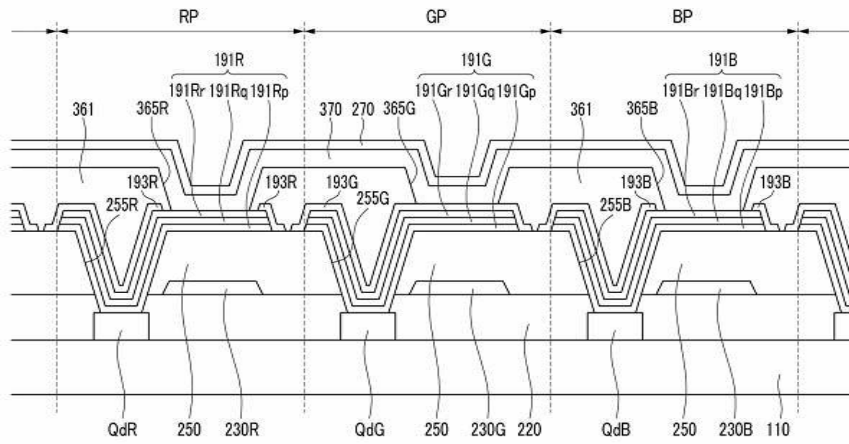
- [0078] 191R, 191G, 191B: 화소 전극 191Rp, 191Gp, 191Bp: 하부막
- [0079] 191Rq, 191Gq, 191Bq: 중간막 191Rr, 191Gr, 191Br: 상부막
- [0080] 193: 투명 도전체막 193R, 193G, 193B: 보조 전극
- [0081] 220: 박막 구조물 230R, 230G, 230B: 색필터
- [0082] 250: 덮개막 255R, 255G, 255B: 접촉 구멍
- [0083] 270: 공통 전극 361: 격벽
- [0084] 365R, 365G, 365B: 개구부 370: 유기 발광 부재
- [0085] Cst: 유지 축전기 ILD: 구동 전류
- [0086] LD: 유기 발광 소자 PX, RP, GP, BP: 화소
- [0087] Qs: 스위칭 트랜지스터
- [0088] Qd, QdR, QdG, QdB: 구동 트랜지스터

도면

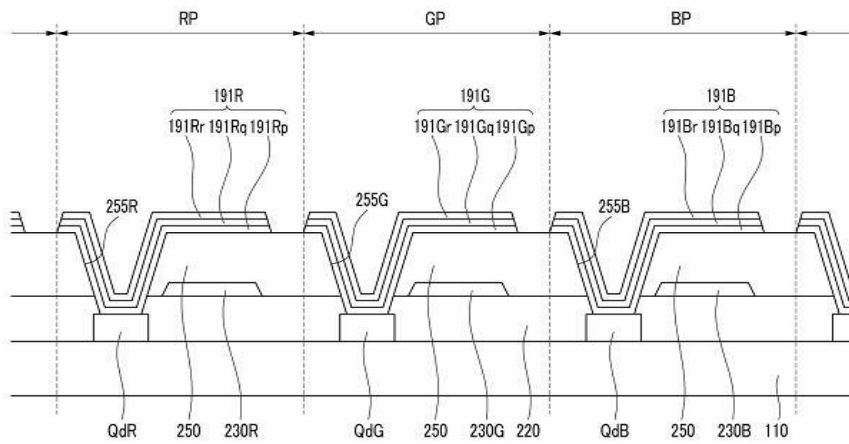
도면1



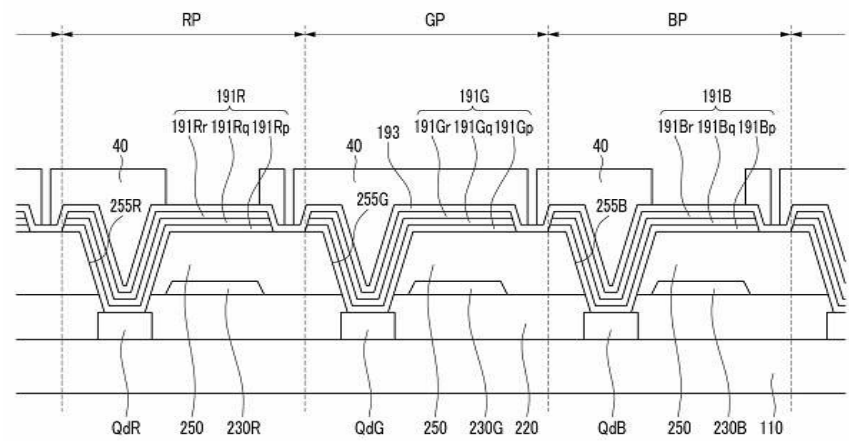
도면2



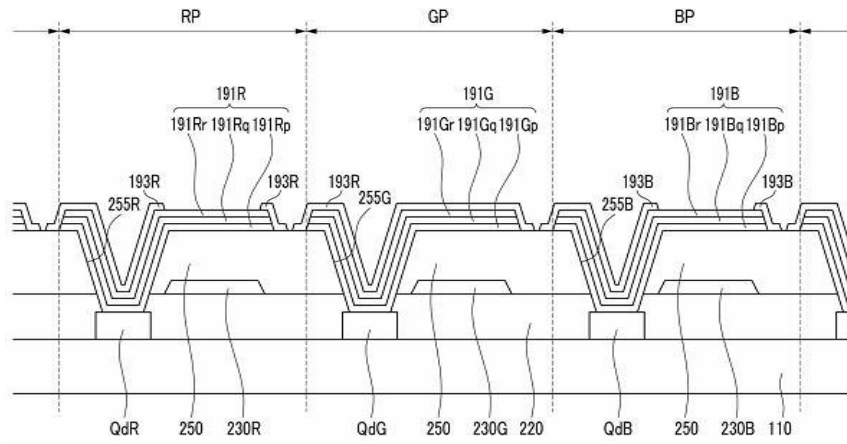
도면3



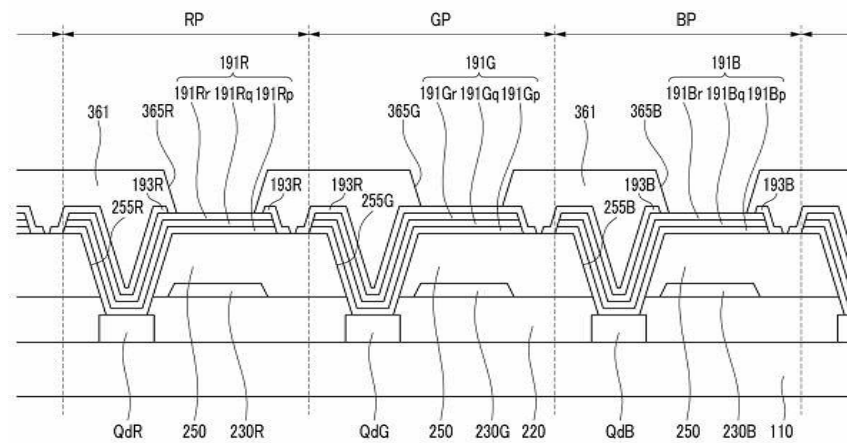
도면4



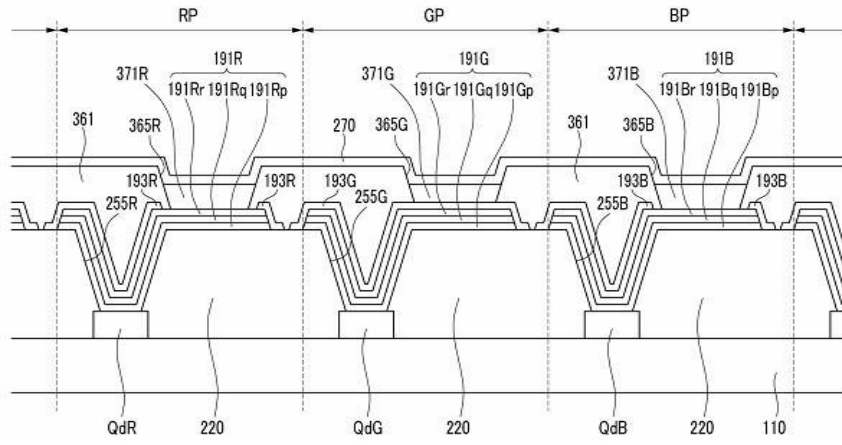
도면5



도면6



도면7



专利名称(译)	标题：OLED显示器及其制造方法		
公开(公告)号	KR101509119B1	公开(公告)日	2015-04-08
申请号	KR1020080069621	申请日	2008-07-17
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
[标]发明人	KIM SOO HYUN 김수현 PARK SUN 박선 YOU CHUN GI 유춘기 PARK JONG HYUN 박종현 LEE DONG KI 이동기 LEE YUL KYU 이율규		
发明人	김수현 박선 유춘기 박종현 이동기 이율규		
IPC分类号	H05B33/26 H01L29/786 H01L51/50		
CPC分类号	H01L27/3248 H01L51/5203		
其他公开文献	KR1020100008969A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

有机发光显示器及其制造方法技术领域本发明涉及有机发光显示器及其制造方法。根据本发明的实施例，提供一种制造有机发光二极管显示器的方法，包括：在包括第一区域，第二区域的基板上形成第一区域，第二区域和第三区域，并且形成第三驱动晶体管，在第一至第三驱动晶体管上形成绝缘膜，在绝缘膜上的第一，第二和第三区域上形成第一，第二和第三像素，在第一至第三像素电极上形成有机发光构件，在第一，第二和第三像素电极上形成有机发光构件，并在其上形成公共电极。

